

第7回九大グラフェン研究会（主催：応用力学研究所）
「グラフェン研究の最前線」

平成27年2月10日（火） 13:00～18:00
於 九州大学応用力学研究所 W601室

1. 13:00～13:05
はじめに 九大院工 田中 悟
2. 13:05～13:35（30分）
九大先導研 吾郷 浩樹 准教授
「エピタキシャル銅系触媒上でのグラフェンの成長ダイナミクスと層数制御」
3. 13:35～14:05（30分）
NTT基礎研 日比野 浩樹 氏
「CVDグラフェンの結晶粒界の可視化と界面制御による機能化」

休憩 14:05～14:15

4. 14:15～14:45（30分）
NTT基礎研 佐々木 健一 氏
「グラフェンにおけるバレー反対称ポテンシャルの理論」
5. 14:45～15:15（30分）
宇部高専 碓 智徳 准教授
「グラフェン/SiC表面の酸化による電子状態変化」
6. 15:15～15:45（30分）
島根大学院工 影島 博之 教授
「SiC上エピタキシャルグラフェン形成機構と制御指針」

休憩 15:45～16:00

7. 16:00～16:30（30分）
九大院工 梶原 隆次/田中 悟
「SiCファセット上の擬1次元グラフェン構造」
8. 16:30～17:00（30分）
筑波大院物質科学 神田 晶申 准教授
「SiC上グラフェンの伝導測定」
9. 17:00～17:30（30分）
東大物性研 小森 文夫 教授
「SiC 巨大ファセット上のグラフェンの π バンドおよびSTM観察」

19:00～懇親会

研究会に関するお尋ねは、エネルギー量子工学部門 田中 まで
（伊都 内線3535, stanaka@nucl.kyushu-u.ac.jp）